

Коэффициентное ударное ионизации носителей заряда в <100> арсениде галлия

Rang, Toomas; Puusepp, Märt Электронная техника. Серия 2, Полупроводниковые приборы : научно-технический сборник 1987 / с. 98-100 https://www.ester.ee/record=b2160501*est

Сверхрезкие вариакпы на эпитаксиальных пленках арсенида галлия, полученные с помощью ионного внедрения

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электронная техника. Серия 2, Полупроводниковые приборы : научно-технический сборник 1977 / с. 99-103 https://www.ester.ee/record=b2160501*est

Формирование Р-слоев при внедрении ионов магния в InSb

Gavrilov, Aleksei; Danilov, J.V.; Katšurin, G.A.; **Mere, Arvo** Электронная техника. Серия 2, Полупроводниковые приборы : научно-технический сборник 1980 / с. 108-112 https://www.ester.ee/record=b2160501*est